EPITA / InfoS3		Décembre 2016
·	. Prénom :	Groupe :



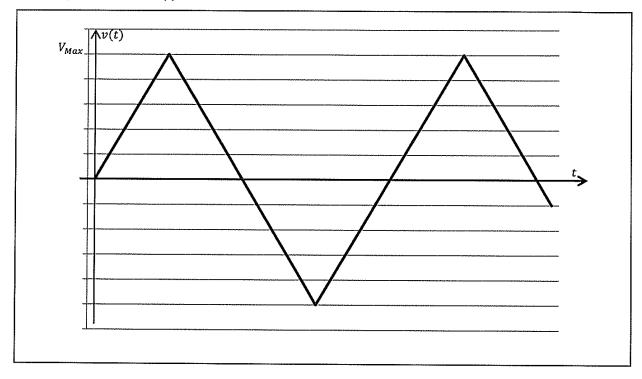
## Partiel Electronique

Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés. Le barème (sur 20,5) est donné à titre indicatif.

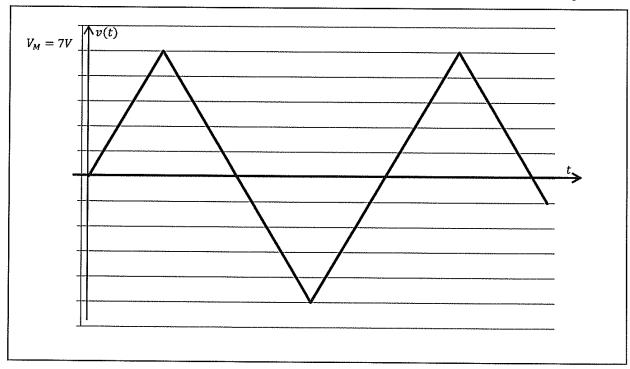
Réponses exclusivement sur le sujet. Si vous manquez de place, vous pouvez utiliser le verso des pages.

# Exercice 1. Redresseur douoble alternance (6 points) $D_1$ Soit le montage ci-contre dans lequel v(t) est un signal périodique triangulaire, représenté questions e et f. Pour les premières questions, on utilise le modèle idéal pour les diodes. a) Durant l'alternance positive ( $0 \le t \le \frac{T}{2}$ ), quelles diodes sont conductrices? Justifiez votre réponse. b) Quelle est alors l'expression de u? c) Durant l'alternance négative $(\frac{T}{2} \le t \le T)$ , quelles diodes sont conductrice? Justifiez votre réponse. d) Quelle est alors l'expression de u?

e) Tracer alors u(t).

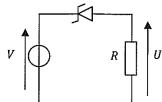


f) On remplace désormais les diodes par leur modèle à seuil. Tracer l'allure de u(t), en justifiant votre réponse. On notera  $V_0$ , la tension de seuil de chacune des diodes et on prendra  $V_0 = 0.7 V$ .



### Exercice 2. Diode Zéner (4 points)

On considère le schéma suivant.  $V \in \mathbb{R}$ 



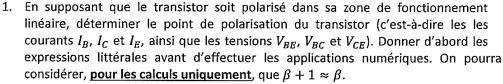
Tracez la caractéristique de transfert c'est-à-dire U = f(V) en substituant la diode par son modèle réel.

diode par son modèle réel.	
Vous préciserez les équations de chaque portion de caractéristique. On not direct, $r_D$ , la résistance interne de la diode en direct, $V_Z$ , la tension de seuil Zéne la diode en inverse.	era $V_0$ la tension de seuil en r et $r_Z$ , la résistance interne de

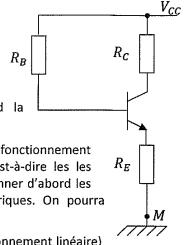
#### Exercice 3. Polarisation du transistor (6 points)

On considère le montage ci-contre, où :

- $R_B = 200k\Omega$ ,  $R_C = 500\Omega$ ,  $R_E = 1k\Omega$ ,  $V_{CC} = 10V$
- <u>Caractéristiques du transistor</u>:  $\beta=100,\ V_{BE}=0.7V$  quand la jonction Base-Emetteur est passante et  $V_{CE_{SAT}}=0.2V$



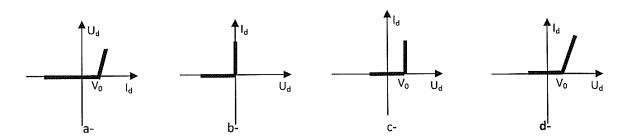
L'hypothèse de départ (transistor polarisé dans sa zone de fonctionnement linéaire) est-elle bien vérifiée ?



2. Quelle est l'expression du courant de saturation $I_{C_{Sat}}$ de ce transistor ?
Exercice 4. Montage Darligton (2 points)
On considère le montage ci-contre. $I_{C2}$
$eta_1$ étant le coefficient de transfert du courant de base (aussi appelé Gain en courant) du transistor de droite et $eta_2$ celui du transistor de $eta_2$ gauche, déterminer le gain en courant $eta$ du transistor équivalent, en fonction de $eta_1$ et $eta_2$ .  On supposera les deux transistors polarisés dans leur zone de fonctionnement linéaire.  Rq: Commencez par exprimer $I_C$ en fonction de $I_B$ .

#### Exercice 5. QCM (2, 5 points - Pas de point négatif)

1. Laquelle de ces caractéristiques correspond à la caractéristique courant/tension du modèle réel de la diode :



- 2. En polarisation inverse, on peut représenter la diode Zéner à l'aide de l'un des 2 modèles : à seuil ou linéaire le modèle idéal n'existant pas pour cette diode.
  - a- VRAI

b- FAUX

#### 3. L'effet transistor :

- a- Permet de faire passer un grand courant entre l'émetteur et le collecteur.
- b- Permet de faire passer un grand courant entre la base et le collecteur.
- c- Permet de faire passer un grand courant entre l'émetteur et la base.
- 4. Lorsque l'on fait fonctionner le transistor comme un interrupteur :
  - a- Le transistor est équivalent à un interrupteur fermé lorsqu'un courant passe dans la base.
  - b- Le transistor est équivalent à un interrupteur fermé lorsqu'aucun courant ne passe dans la base.
  - c- Le transistor est équivalent à un interrupteur ouvert lorsqu'un courant passe dans la base.
  - d- Le transistor est équivalent à un interrupteur ouvert lorsqu'aucun courant ne passe dans la base.